

10/511389

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
23. Oktober 2003 (23.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/087426 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C23C 14/34

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/01216

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. April 2003 (11.04.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 16 671.4 15. April 2002 (15.04.2002) US

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): APPLIED FILMS GMBH & CO. KG [DE/DE];
Siemensstrasse 100, 63755 Alzenau (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GEISLER, Michael
[DE/DE]; Triebstrasse 63, 63607 Wächtersbach (DE).
KASTNER, Albert [DE/DE]; Hanauer Landstrasse
37 b, 63457 Hanau (DE). SZYSZKA, Bernd [DE/DE];
Danzinger Strasse 24, 38108 Braunschweig (DE). PFLUG,
Andreas [DE/DE]; Berliner Allee 43, 30175 Hannover
(DE). MALKOMES, Niels [DE/DE]; Karlstrasse 75,
38106 Braunschweig (DE).

(74) Anwalt: SCHLAGWEIN, Udo; Frankfurter Strasse 34,
61231 Bad Nauheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT
(Gebrauchsmuster), AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY,
BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ (Gebrauchsmuster),
CZ, DE (Gebrauchsmuster), DK (Gebrauchsmuster),
DK, DM, DZ, EC, EE (Gebrauchsmuster), EE, ES, FI
(Gebrauchsmuster), FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, NI,
NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK
(Gebrauchsmuster), SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

WO 03/087426 A2

(54) Title: COATING INSTALLATION

(54) Bezeichnung: BESCHICHTUNGSANLAGE

(57) Abstract: The invention relates to a coating installation comprising a recipient (1) which is divided into a cathode side (3) and a substrate side (4) by means of a screen (2). The cathode side (3) and the substrate side (4) respectively have a direct extraction outlet (10, 16) and a gas admission (8, 14). The gas admission (8) on the cathode side (3) is connected to a process gas source (9) and the gas admission (14) for the substrate side (4) is connected to a reactive gas source (15).

(57) Zusammenfassung: Bei einer Beschichtungsanlage ist ein Rezipient (1) durch eine Blende (2) in einen Kathodenraum (3) und einen Substratraum (4) unterteilt. Sowohl der Kathodenraum (3) als auch der Substratraum (4) weisen eine unmittelbare Absaugung (10, 16) und jeweils eine eigene Gaszuführung (8, 14) auf. Die Gaszuführung (8) in den Kathodenraum (3) ist mit einer Prozessgasquelle (9) und die Gaszuführung (14) für den Substratraum (4) mit einer Reaktivgasquelle (15) verbunden.

Beschreibung

Beschichtungsanlage

Die Erfindung betrifft eine Beschichtungsanlage mit einem eine Absaugung und eine Gaszuführung aufweisenden Rezipienten, in welchem eine Zerstäuberkathode und ein Substrathalter untergebracht sind und bei der der Rezipient durch eine zwischen der Zerstäuberkathode und dem Substrathalter angeordnete Blende in einen Kathodenraum und einen Substratraum unterteilt ist.

Eine Beschichtungsanlage der vorstehenden Art ist Gegenstand der EP 0 795 623. Bei der in dieser Schrift gezeigten Beschichtungsanlage strömt aus Argon und Sauerstoff bestehendes Prozessgas nahe des Substrates in den Substratraum und wird oberhalb der Blende über eine Absaugung am Kathodenraum abgeführt. Eine als Lambda-Sonde ausgeführte Messeinrichtung im Kathodenraum dient dazu, den Sauerstoffgehalt im Kathodenraum zu überwachen und nach dem Sauerstoffgehalt die Leistung der Zerstäuberkathode zu steuern. Durch die gemeinsame Zuführung des Reaktivgases und des Prozessgases und durch die Abführung des Gases über eine Absaugung am Kathodenraum lässt sich nicht vermeiden, dass das Target der Zerstäuberkathode einer beträchtlichen Sauerstoffkonzentration ausgesetzt ist. Dadurch kommt es zu einer unerwünschten Oxidation des Targets, wodurch sich anstelle einer erwünschten hohen metallischen Oxidationsrate eine niedrige oxidische Oxidationsrate ergibt. Die Blende gemäß der EP 0 795 623 hat den Sinn, eine Minderung der Schichtqualität durch Schrägbeschichtung zu unterbinden.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Beschichtungsanlage der eingangs genannten Art so zu gestalten, dass eine ausreichend hohe Konzentration von Reaktivgas möglich ist, um eine vollständige Reaktion der sich bildenden Schicht zu ermöglichen, ohne dass dadurch zugleich die Targetoberfläche in unerwünschter Weise mit dem Reaktivgas reagiert und es dadurch zu einer Leistungsverminderung der Beschichtungsanlage kommt.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass sowohl der Kathodenraum als auch der Substratraum eine unmittelbare Absaugung und jeweils eine eigene Gaszuführung aufweisen und dass die Gaszuführung in den Kathodenraum mit einer Prozessgasquelle und die Gaszuführung für den Substratraum mit einer Reaktivgasquelle Verbindung hat.

Durch diese Gestaltung der Beschichtungsanlage kommt es zu weitgehend unabhängigen Gasströmungen in dem Kathodenraum und dem Substratraum. Das Reaktivgas wird erfindungsgemäß durch die Blende vom Sputtervorgang abgeschirmt. Dadurch gelangen nur noch unbedeutende Mengen des Reaktivgases - im Regelfall Sauerstoff - in den Kathodenraum, so dass es zu keiner Reaktion der Targetoberfläche und damit einer Verringerung der Beschichtungsleistung der Beschichtungsanlage kommt. Der Fluss der die Schicht bildenden, von der Targetoberfläche stammenden Teilchen gelangt durch die Öffnung der Blende hindurch zum Substrat. Dank der erfindungsgemäßen Ausbildung von zwei separaten Gasströmungen im Rezipienten kann die Öffnung in der Blende groß sein, so dass die von der Targetoberfläche stammenden Teilchen auf dem Weg zum Substrat wenig behindert werden, ohne dass umgekehrt unerwünscht viel Sauerstoff die Zerstäubungskathode erreicht und es dort zu einer Oxidation kommt. Es zeigte sich, dass die Abblendwirkung der Blende für die gesputterten Teilchen

sich durch die mögliche Ratenerhöhung am Target aufgrund des dort geringeren Reaktivgasanteils überkompensieren lässt. Besonders deutliche Steigerungen der spezifischen Beschichtungsleistung ergaben sich mit der erfindungsgemäßen Beschichtungsanlage bei der Erzeugung von transparenten SnO- und ZnO-Schichten mit reaktiv betriebenen DC-Zerstäuber-kathoden.

Eine besonders gute Trennung der Gasströme ergibt sich, wenn der Kathodenraum und der Substratraum jeweils mit einem eigenen Unterdruckpumpstand verbunden sind.

Zur weiteren Trennung der beiden Gasströme trägt es bei, wenn sowohl im Kathodenraum als auch im Substratraum die Gaszuführung und die Absaugung an gegenüberliegenden Seiten angeordnet sind.

Zur weiteren Verbesserung der Schichtqualität trägt es bei, wenn im Rezipienten zwischen der Zerstäuber-kathode und dem Substrat eine Anode angeordnet ist.

Der Einfluss des Plasmaglows auf das Schichtwachstum wird möglichst wenig gehemmt, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung die Anode im Substratraum von der Blende abgedeckt zwischen der Blende und dem Substrat angeordnet ist. Eine solche Anode bewirkt, dass sich der Plasmaglow durch die Blendenöffnung hindurch über die Beschichtungsstelle des Substrates hinweg in Richtung der Schlitzschleuse erstreckt. Hierdurch lassen sich auch die Schichteigenschaften verbessern. Insbesondere ist durch eine solche Anodenanordnung eine hohe Schichtdicke zu erreichen. Da die Anode von der Blende abgedeckt ist, kommt es zu keiner nennenswerten Beschichtung der Anode.

Die Anode kann auf übliche Weise ausgebildet sein. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Anode durch zwei unbe-

heizte Rohre gebildet ist. Da SnO und ZnO eine relativ hohe Leitfähigkeit besitzen, spielt die während des Beschichtungsvorganges des Substrates zwangsläufig erfolgende Beschichtung der Anode und ihr damit eintretender Wirkungsverlust bei solchen Beschichtungsmaterialien keine Rolle. Es kann jedoch auch vorgesehen werden, die Anode, umgeben mit einem schwachen Magnetfeld, pulsweise auf negatives Potential zu setzen, um sie leitfähig und sauber zu halten.

Möglich ist es jedoch auch vorzusehen, dass die Anode zugleich die Blende bildet.

Der weiteren Leistungssteigerung der Beschichtungsanlage dient es, wenn die Kathode eine Doppel-Magnetronkathode ist.

Das Target wird möglichst gleichmäßig abgetragen und hat deshalb eine möglichst lange Lebensdauer, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung die Kathode eine Rotationskathode ist.

Oxidische und damit geringe Erosionsraten des Targets lassen sich zuverlässig vermeiden, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfindung im Kathodenraum eine Messeinrichtung für Reaktivgas angeordnet ist und die Beschichtungsanlage eine Leistungsregelung der Zerstäuberkathode in Abhängigkeit von der Konzentration des Reaktivgases in dem Kathodenraum aufweist.

Als besonders vorteilhaft hat sich herausgestellt, wenn das Verhältnis der in Transportrichtung des Substrates gemessenen Blendenöffnungslänge der Blende zur in Transportrichtung des Substrates gemessenen Breite der Zerstäuberkathode weniger als 0,75, vorzugsweise 0,5 bis 0,3 beträgt.

Die Erfindung lässt verschiedene Ausführungsformen zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips ist eine davon schematisch in der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben.

Die Zeichnung zeigt im Schnitt eine erfindungsgemäße Beschichtungsanlage. Diese hat einen Rezipienten 1, der durch eine Blende 2 in einen Kathodenraum 3 und einen Substratraum 4 unterteilt ist. Im Kathodenraum 3 befindet sich eine elektrisch gegenüber dem Rezipienten 1 isolierte Zerstäuerkathode 5, die bei diesem Ausführungsbeispiel als Magnetronkathode ausgebildet ist und an der Seite der Blende 2 ein Target 6 aufweist. Unterhalb der Blende 2 und von dieser abgedeckt ist im Substratraum 4 eine Anode 7 angeordnet. In der Zeichnung gesehen an der linken Seite des Kathodenraumes 3 befindet sich eine Gaszuführung 8, die mit einer Prozessgasquelle 9 verbunden ist. An der gegenüberliegenden Seite des Kathodenraumes 3 ist eine Absaugung 10 mit einem Unterdruckpumpstand 11 angeordnet.

Im Substratraum 4 befindet sich ein Substrathalter 12 mit einem zu beschichtenden Substrat 13. Das Verhältnis der in Transportrichtung des Substrates 13 gemessenen Blendenöffnungslänge der Blende 2 zur in Transportrichtung des Substrates 13 gemessenen Breite der Zerstäuerkathode 5 beträgt weniger als 0,75, vorzugsweise 0,5 bis 0,3. Genau wie der Kathodenraum 3 hat der Substratraum 4 an der gleichen Seite wie der Kathodenraum 3 eine Gaszuführung 14, die mit einer Reaktivgasquelle 15 Verbindung hat. Weiterhin ist der Gaszuführung 14 gegenüberliegend eine Absaugung 16 mit einem Unterdruckpumpstand 17 vorgesehen.

Zur Regelung des Beschichtungsvorganges ist in dem Kathodenraum 3 eine als Lambdasonde ausgebildete Messeinrich-

tung 18 mit einer Sondenheizung 20 angeordnet, welche mit einer Leistungsregelung 19 der Zerstäuber-kathode 5 Verbindung hat. Dadurch wird die Konzentration des Reaktivgases in dem Kathodenraum 3 - im Regelfall die Sauerstoffkonzentration - gemessen und danach die Spannung der Zerstäuber-kathode 5 geregelt.

Bezugszeichenliste

- 1 Rezipient
- 2 Blende
- 3 Kathodenraum
- 4 Substratraum
- 5 Zerstäuber-kathode
- 6 Target
- 7 Anode
- 8 Gaszuführung
- 9 Prozessgasquelle
- 10 Absaugung
- 11 Unterdruckpumpstand
- 12 Substrathalter
- 13 Substrat
- 14 Gaszuführung
- 15 Reaktivgasquelle
- 16 Absaugung
- 17 Unterdruckpumpstand
- 18 Messeinrichtung
- 19 Leistungsregelung
- 20 Sondenheizung

Patentansprüche

1. Beschichtungsanlage mit einem eine Absaugung und eine Gaszuführung aufweisenden Rezipienten (1), in welchem eine Zerstäuberkathode (5) und ein Substrathalter (12) untergebracht sind und bei der der Rezipient (1) durch eine zwischen der Zerstäuberkathode (5) und dem Substrathalter (12) angeordnete Blende (2) in einen Kathodenraum (3) und einen Substratraum (4) unterteilt ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass sowohl der Kathodenraum (3) als auch der Substratraum (4) eine unmittelbare Absaugung (10, 16) und jeweils eine eigene Gaszuführung (8, 14) aufweisen und dass die Gaszuführung (8) in den Kathodenraum (3) mit einer Prozessgasquelle (9) und die Gaszuführung (14) für den Substratraum (4) mit einer Reaktivgasquelle (15) Verbindung hat.
2. Beschichtungsanlage nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kathodenraum (3) und der Substratraum (4) jeweils mit einem eigenen Unterdruckpumpstand (11, 17) verbunden sind.
3. Beschichtungsanlage nach den Ansprüchen 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass sowohl im Kathodenraum (3) als auch im Substratraum (4) die Gaszuführung (8, 14) und die Absaugung (10, 16) an gegenüberliegenden Seiten angeordnet sind.
4. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Rezipienten (1) zwischen der Zerstäuberkathode (5) und dem Substrat (13) eine Anode (7) angeordnet ist.
5. Beschichtungsanlage nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Anode (7) im Substratraum (4) von der

Blende (2) abgedeckt zwischen der Blende (2) und dem Substrathalter (12) angeordnet ist.

6. Beschichtungsanlage nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Anode (7) durch zwei unbeheizte Rohre gebildet ist.

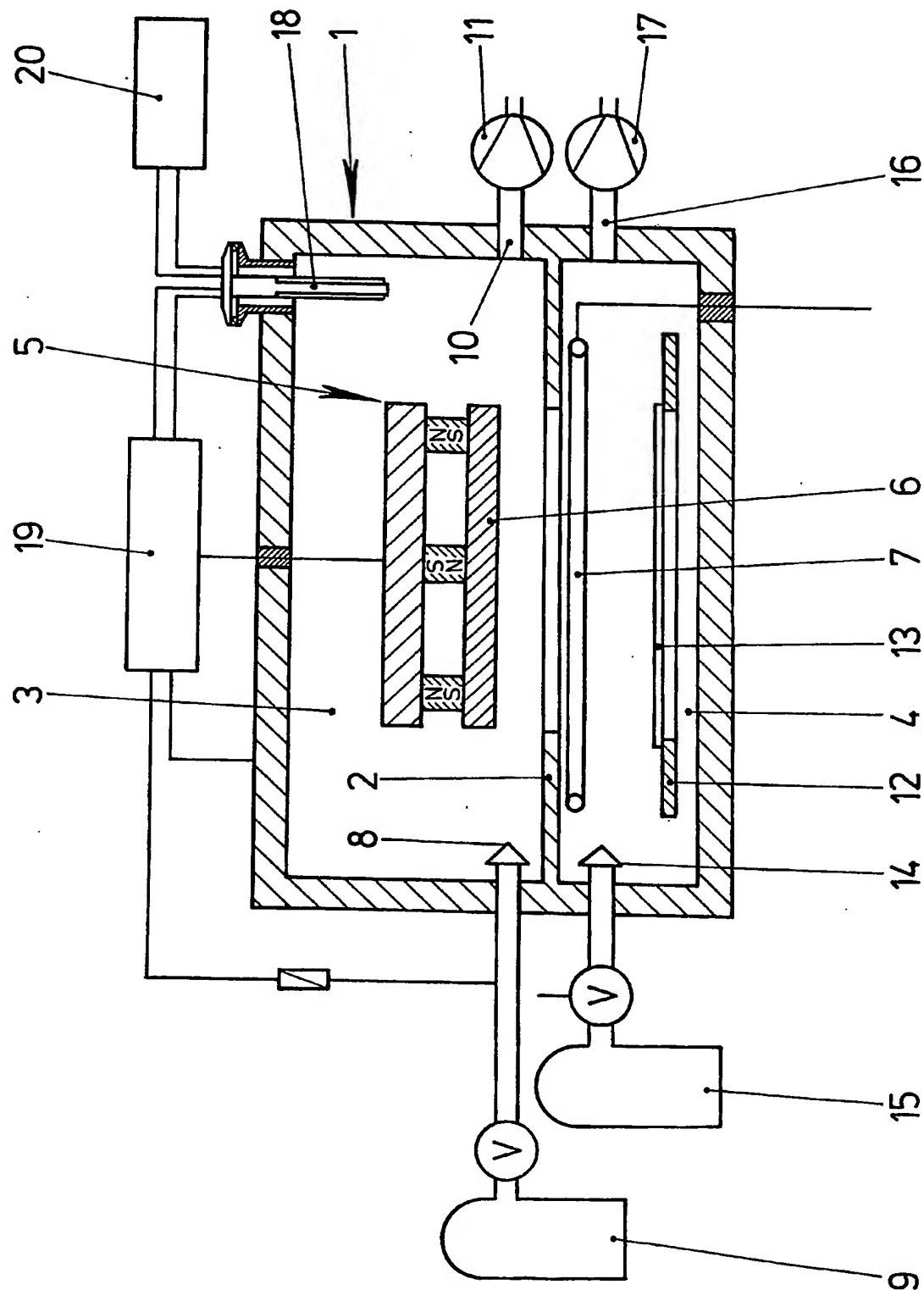
7. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Anode (7) zugleich die Blende (2) bildet.

8. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zerstäuber-kathode (5) eine Doppel-Magnetronkathode ist.

9. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zerstäuber-kathode (5) eine Rotationskathode ist.

10. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Kathodenraum (3) eine Messeinrichtung (18) für Reaktivgas angeordnet ist und die Beschichtungsanlage eine Leistungsregelung (19) der Zerstäuber-kathode (5) in Abhängigkeit von der Konzentration des Reaktivgases in dem Kathodenraum (3) aufweist.

11. Beschichtungsanlage nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verhältnis der in Transportrichtung des Substrates (13) gemessenen Blendenöffnungslänge der Blende (2) zur in Transportrichtung des Substrates (13) gemessenen Breite der Zerstäuber-kathode (5) weniger als 0,75, vorzugsweise 0,5 bis 0,3 beträgt.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internatl Application No
PCT/L 03/01216

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C23C14/00 H01J37/34

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 C23C H01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 908 531 A (CANON KK) 14 April 1999 (1999-04-14)	1,3,4,6, 7,11
Y	paragraphs '0033!-'0035!,'0041!,'0042!; figure 2	5,8-10
X	EP 0 860 513 A (CANON KK) 26 August 1998 (1998-08-26)	1,2,4,6, 7,11
	column 16, line 52 -column 18, line 14; figure 9	
Y	US 4 392 939 A (CROMBEEN JACOBUS E ET AL) 12 July 1983 (1983-07-12)	5
	column 2, line 60 -column 3, line 19; figure 1	
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 December 2003

Date of mailing of the international search report

17/12/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hoyer, W

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internatl Application No

PCT/JP 03/01216

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 5 427 665 A (HARTIG KLAUS ET AL) 27 June 1995 (1995-06-27) column 3, line 53 -column 4, line 51; claims 1,6,8; figures 2-4 ---	8,9
Y	EP 0 701 270 A (BOC GROUP INC) 13 March 1996 (1996-03-13) column 3, line 40 -column 4, line 50; figure 1 ---	8,9
Y	EP 0 795 623 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) 17 September 1997 (1997-09-17) column 2, line 57 -column 3, line 45; figures 1-3 -----	10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 Internat Application No
 PCT/JP 03/01216

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0908531	A	14-04-1999	EP 0908531 A2	14-04-1999
			JP 11172430 A	29-06-1999
			US 6238527 B1	29-05-2001
EP 0860513	A	26-08-1998	EP 0860513 A2	26-08-1998
			EP 0860514 A2	26-08-1998
			JP 3332839 B2	07-10-2002
			JP 11001771 A	06-01-1999
			JP 3332840 B2	07-10-2002
			JP 10298753 A	10-11-1998
			US 6451184 B1	17-09-2002
			US 6200431 B1	13-03-2001
US 4392939	A	12-07-1983	NL 8200902 A	03-10-1983
			AT 22752 T	15-10-1986
			AU 560381 B2	02-04-1987
			AU 1203283 A	08-09-1983
			CA 1192318 A1	20-08-1985
			DE 3366772 D1	13-11-1986
			EP 0088463 A1	14-09-1983
			ES 8401678 A1	01-03-1984
			JP 1591463 C	30-11-1990
			JP 2014425 B	09-04-1990
			JP 58164783 A	29-09-1983
US 5427665	A	27-06-1995	DE 4025231 A1	16-01-1992
			DE 4038577 A1	11-06-1992
EP 0701270	A	13-03-1996	AU 2857595 A	21-03-1996
			CA 2156350 A1	07-03-1996
			CN 1126365 A	10-07-1996
			DE 69508011 D1	08-04-1999
			DE 69508011 T2	15-07-1999
			EP 0701270 A1	13-03-1996
			JP 8170172 A	02-07-1996
			SG 32468 A1	13-08-1996
			US 5645699 A	08-07-1997
			ZA 9506811 A	14-05-1996
EP 0795623	A	17-09-1997	DE 19609970 A1	18-09-1997
			DE 59609093 D1	23-05-2002
			EP 0795623 A1	17-09-1997
			ES 2173243 T3	16-10-2002
			JP 10008247 A	13-01-1998
			KR 269006 B1	16-10-2000
			TW 419527 B	21-01-2001
			US 2002157945 A1	31-10-2002

PCT/US 03/01216

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/JL 03/01216

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
Y	US 5 427 665 A (HARTIG KLAUS ET AL) 27. Juni 1995 (1995-06-27) Spalte 3, Zeile 53 -Spalte 4, Zeile 51; Ansprüche 1,6,8; Abbildungen 2-4 ---	8,9
Y	EP 0 701 270 A (BOC GROUP INC) 13. März 1996 (1996-03-13) Spalte 3, Zeile 40 -Spalte 4, Zeile 50; Abbildung 1 ---	8,9
Y	EP 0 795 623 A (LEYBOLD SYSTEMS GMBH) 17. September 1997 (1997-09-17) Spalte 2, Zeile 57 -Spalte 3, Zeile 45; Abbildungen 1-3 -----	10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/JL 03/01216

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0908531	A	14-04-1999	EP 0908531 A2	14-04-1999
			JP 11172430 A	29-06-1999
			US 6238527 B1	29-05-2001
EP 0860513	A	26-08-1998	EP 0860513 A2	26-08-1998
			EP 0860514 A2	26-08-1998
			JP 3332839 B2	07-10-2002
			JP 11001771 A	06-01-1999
			JP 3332840 B2	07-10-2002
			JP 10298753 A	10-11-1998
			US 6451184 B1	17-09-2002
			US 6200431 B1	13-03-2001
US 4392939	A	12-07-1983	NL 8200902 A	03-10-1983
			AT 22752 T	15-10-1986
			AU 560381 B2	02-04-1987
			AU 1203283 A	08-09-1983
			CA 1192318 A1	20-08-1985
			DE 3366772 D1	13-11-1986
			EP 0088463 A1	14-09-1983
			ES 8401678 A1	01-03-1984
			JP 1591463 C	30-11-1990
			JP 2014425 B	09-04-1990
			JP 58164783 A	29-09-1983
US 5427665	A	27-06-1995	DE 4025231 A1	16-01-1992
			DE 4038577 A1	11-06-1992
EP 0701270	A	13-03-1996	AU 2857595 A	21-03-1996
			CA 2156350 A1	07-03-1996
			CN 1126365 A	10-07-1996
			DE 69508011 D1	08-04-1999
			DE 69508011 T2	15-07-1999
			EP 0701270 A1	13-03-1996
			JP 8170172 A	02-07-1996
			SG 32468 A1	13-08-1996
			US 5645699 A	08-07-1997
			ZA 9506811 A	14-05-1996
EP 0795623	A	17-09-1997	DE 19609970 A1	18-09-1997
			DE 59609093 D1	23-05-2002
			EP 0795623 A1	17-09-1997
			ES 2173243 T3	16-10-2002
			JP 10008247 A	13-01-1998
			KR 269006 B1	16-10-2000
			TW 419527 B	21-01-2001
			US 2002157945 A1	31-10-2002